

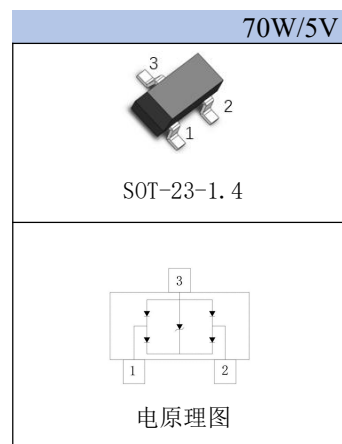
## ZL4D25S4P 型瞬态电压抑制二极管阵列

### 1 特性

- 芯片采用外延平面结构；
- 低电容，响应时间快，双通道；
- 重量 (mg):  $9.4 \pm 1$ ；
- 潮湿敏感度等级：3 级。

### 2 质量等级及执行标准

G 级: QZJ840611、Q/RBJ1016QZ	G+: Q/RBJ1016QZ、Q/RBJ-GL-02JS-04A
J 级: Q/RBJ-GL-02JS-01A	



### 3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数	$P_{\text{PPM}}$ $t_p=8/20 \mu\text{s}$ W	$I_{\text{PP}}$ $t_p=8/20 \mu\text{s}$ A	$V_{\text{RWM}}$ V	$T_{\text{OP}}$ $^\circ\text{C}$	$T_j$ $^\circ\text{C}$	$T_{\text{stg}}$ $^\circ\text{C}$
产品型号						
ZL4D25S4P	70	4.0	5.0	-55~125	-55~150	-55~150

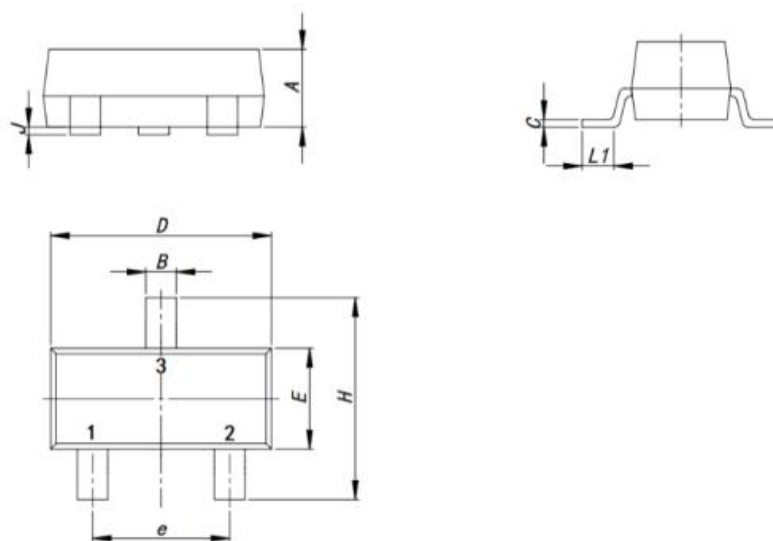
### 4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数符号	测试条件	数值		单位
			最小值	最大值	
1	$V_{\text{BR}}$	引脚 1、2 分别对 3， $I_{\text{R}}=1\text{mA}$	7.0	8.5	V
2	$V_{\text{F}}$	引脚 3 分别对 1、2， $I_{\text{F}}=1\text{mA}$	0.5	1.0	V
3	$V_{\text{C1}}$	$I_{\text{PP}}=1.0\text{A}$ ， $t_p=8/20 \mu\text{s}$	—	15	V
4	$V_{\text{C2}}$	$I_{\text{PP}}=4.0\text{A}$ ， $t_p=8/20 \mu\text{s}$	—	23	V
5	$I_{\text{R}}$	$V_{\text{R}}=5.0\text{V}$	—	0.5	$\mu\text{A}$
6	$C_{\text{j}}$	$V_{\text{R}}=0$ ， $f=1\text{MHz}$ 1脚或2脚到3脚	—	1.0	pF
7	$C_{\text{j}}$	$V_{\text{R}}=0$ ， $f=1\text{MHz}$ 1脚到2脚之间	—	0.5	pF

## 5 外观尺寸



单位:mm

符号 尺寸	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>e</i>	<i>J</i>	<i>H</i>	<i>L1</i>
最小值	0.79	0.30	0.05	2.70	1.07	1.70	—	2.22	0.16
最大值	1.19	0.50	0.25	3.10	1.47	2.10	0.184	2.62	0.36

图 1 SOT-23-1.4 外形尺寸